

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



ПАТЕНТ

НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ

№ 113072

ПОЛУПРОВОДНИКОВАЯ НАНОГЕТЕРОСТРУКТУРА СО СТУПЕНЧАТОЙ КВАНТОВОЙ ЯМОЙ AlGaAs/GaAs/InGaAs/GaAs/AlGaAs НА ПОДЛОЖКЕ GaAs С КОМБИНИРОВАННЫМ ЛЕГИРОВАНИЕМ

Патентообладатель(ли): *Хабибуллин Рустам Анварович (RU)*

Автор(ы): *Хабибуллин Рустам Анварович (RU), Васильевский Иван Сергеевич (RU), Галиев Галиб Бариевич (RU), Климов Евгений Александрович (RU), Пономарев Дмитрий Сергеевич (RU)*

Заявка № 2011141221

Приоритет полезной модели **12 октября 2011 г.**

Зарегистрировано в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации **27 января 2012 г.**

Срок действия патента истекает **12 октября 2021 г.**

Руководитель Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

Б.П. Симонов

